

南京招微集成电路有限公司 NanJing Top Power ASIC Corp.

数据手册 DATASHEET

TP5602 TP5602B 移动电源 专用 4 合 1 单片系统

(低成本同步型 3A锂电池充电、5V3A 升压、显示、电池保护)

REV_2.1



TP5602、TP5602B 移动电源专用 4 合 1 单片系统

概述

TP5602 与 TP5602B 只在升压模式时,LED 灯显示模式有区别。TP5602 在 按键升压或自动升压工作时 LED 灯亮 3S, 然后熄灭; TP5602B 升压工作时则为 长亮, 直至升压停机, LED 熄灭。两者其他功能、典型应用电路图、注意事项、 封装等均相同,下文未特别说明,均为介绍 TP5602 芯片。

TP5602 是一款全集成功能的移动电源专用超大规模集成电路,专为中大功率移动电源设计。内部将自动充电管理和电池隔离 PMOS2、升压管理、电量显示、电池保护等多种功能集成到单一芯片中,外加一个输入隔离 PMOS1,一个功率 NMOS1,一个电感,少量阻容元件,应用电路简单,性能稳定可靠,免调试大生产,高效高良率。

TP5602 采用独特的单一电感复用技术,内置高效同步降压 4.2V3A 锂电池 充电电路和同步升压型 5V 3A 输出电路; 4 路 LED 显示输出可以 5 段显示充电和放电时的电量,可适用于红、绿、蓝光 LED 直接驱动,也同时用于异常状态报警显示;无需外部电池保护电路,内部集成电池多种输入和输出保护(过压、过充、欠压、过流、短路等);

TP5602 提供功能设置: 插电自动充电,按键升压,轻载自动停机(升压时);降压充电恒流可调: 5V 升压输出恒流外部可调。

其 QFN24 超小型封装与简单的外围电路,使得 TP5602 也非常适用于其他 便携式设备的大功率独立充电或独立的升压管理应用。

TP5602 具有宽输入电压(4.2-7V MAX),有防电源反接,充电时对电池充电分为涓流预充、恒流、恒压三个阶段,涓流预充电电流、恒流充电电流都通过外部电阻调整,最大充电电流达 3.5A。充电不同的电池电压时,4LED 不同的显示模式。充电开关频率 700KHz 的开关工作模式使它可以使用较小的外围器件,并在大电流充电中仍保持较小的发热量。

TP5602 内置 4.25V VIO 充电自适应电路,当 VIO 电流驱动不够引起 VIO 下降到 4.2V 时,内部自动减少充电电流,用户不必担心设置电流过大而遇到小功率的 USB 口、电源或适配器的问题。

TP5602 内置防电池倒灌 PMOS2 电路,所以无需防倒灌肖特基二极管等外围保护。

TP5602 同步升压电路可以恒压限流输出,电压内部固定 5V,电流可达 3A。限流值可以通过外部设置调整(VIlmt),限制电池端输出电流,从而控制 VIO 输出功率。

升压启动时有软启动保护,有输出短路和过流保护(250mS 长时过流/短路停机)。

外置 NMOS,逐周期限流。典型可以驱动 5V3A,极限驱动 3.5A,5V3A@Vbat=4V效率 93.5%。



特性

对本机电池充电:

- 单节4.2V锂电池充电,典型3A
- 宽工作电压,最大达到7V
- 可旁路输出,电源功率自适应
- 防电源反接,防电池过压**4.3V双重 保护,更安全**
- 内置功率管理PMOS2,全同步开关型模式
- 涓流、恒流、恒压三段充电,保护 电池
- 可编程充电电流ISET, 0.1A--3A
- 预充电涓流: 20%ISET 恒压停机电流: 20%ISET
- 4路LED充电状态指示,最高位闪烁
- 芯片过温度自动降功率保护,欠压 保护
- 电池端短路保护
- 内置多种电池保护,可**无须外部保** 护芯片
- 开关频率700KHz,典型电感2.2uH
- 4.2V±1%的充电电压控制精度
- 采用QFN24 4mm*4mm 超小型封装

升压电路:

- 按键启动VIO, 固定5V输出
- 按键长按2.5S, 升压关断, 进入待机 模式
- 可调最大输出恒流,典型输出5V3A
- ■4路LED电量状态指示,3秒后自动灭 灯(**TP5602B灯为长亮**),电池小 于3V报警6次保护,小于2.4V全停 机,不动作
- 芯片过温度保护,自动降低输出电流,欠压、过流、短路自动待机保护
- 开关频率300KHz
- 轻载(输出<30mA)10秒后自动待机
- 待机后电池电流低至 6uA
- 典型输出5V 3A, 4V Vbat典型输出 效率93.5%。最大输出5V 3.5A。

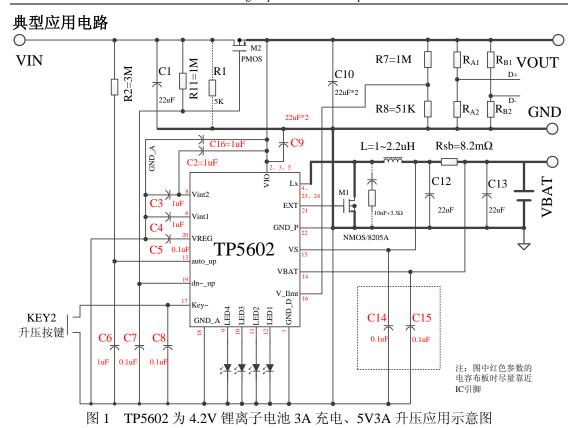
绝对最大额定值

- VIN: $-10 \sim +9V$
- VBAT: -0.7V~5V
- 最大结温: 145℃
- 工作环境温度范围: -40℃~85℃
- 贮存温度范围: -65℃~125℃
- 引脚温度 (焊接时间10秒): 260℃

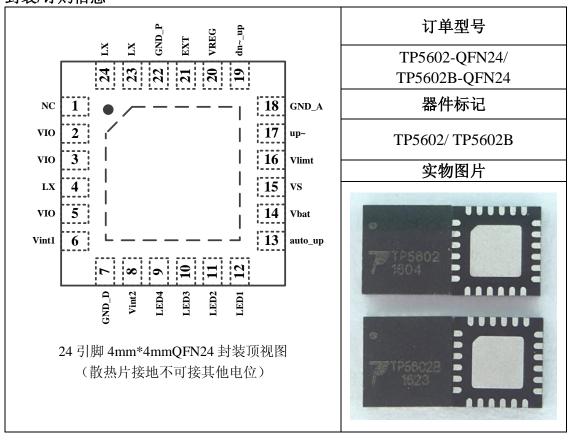
应用范围

- 移动电源
- 便携式设备
- 电子烟





封装/订购信息





功能方框图

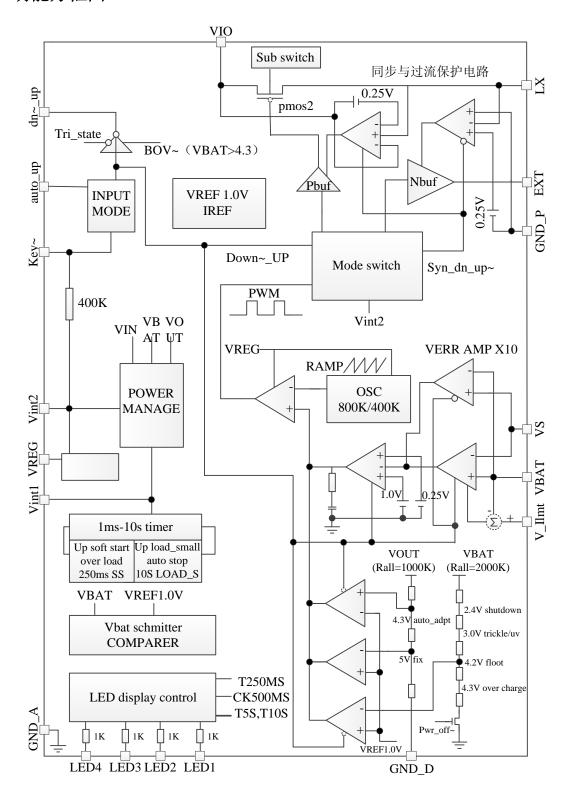


图 2 功能模块框图



电特性

表1 TP5602电特性能参数

凡表注◆表示该指标适合整个工作温度范围,图 1 典型电路,否则仅指 T_A =25 $^{\circ}$ C,VIO=5V,除非特别注明。Ron_nmos1=15m Ω ,Ron_pmos1=60m Ω 。

符号	参数	条件		最小值	典型值	最大值	单位
	降压充电部分						
VIN	输入电源电压		•	4.2	5	7.0	V
$ m I_{VIN}$	输入电源电流(无灯)	充电模式, R_{Sb} =0.1 Ω 特机模式(VB =4.25) 停 机 模 式(V_{in} < V_{BAT} ; 或 V_{in} < V_{UV})	•		240 550 550 550	750 750 750	mA μA μA
V_{FLOAT}	充电截止电压	Rsb=0.1Ω 4.2V 锂离子电池		4.160	4.2	4.250	V
Vsb	恒流设置电压基准精度	Rsb=0.1Ω		22	25	28	mV
${ m I_{BAT}}$	BAT 引脚电流: (电流模式测试条件是 电池=3.8V)	R_S = 0.1Ω ,恒流模式 R_S = $8.2m\Omega$,恒流模式 待机模式, V_{BAT} = $4.25V$ VIN = $0V$, V_{BAT} = $4.25V$	•	0	250 3 -6 -6	-10 -10	mA A uA uA
I_{TRIKL}	涓流预充电电流	$1.2V < V_{BAT} < V_{TRIKL}$, $R_S = 8.2m\Omega$	•		600		mA
Fdn	振荡频率			600	700	800	KHz
Dмах	最大占空比				100%		
DMIN	最小占空比			0%			
V_{TRIKL}	涓流充电门限电压(4.2V)	R _S =0.1Ω,V _{BAT} 上升		2.8	2.9	3.0	V
V_{TRHYS}	涓流充电迟滞电压	$R_S=0.1\Omega$		60	80	100	mV
V_{UV}	V _{IN} 欠压闭锁门限	从V _{IN} 低至高	•	3.7	3.8	4.0	V
V_{UVHYS}	V _{IN} 欠压闭锁迟滞		•	150	200	300	mV
V_{ADPT}	V _{IN} 自适应启动电压	V _{IN} 从高到低		4.15	4.25	4.35	mV
IB_{TERM}	ISET/5 终止电流门限	$R_S=0.1\Omega$	•	40	50	70	mA
VLED	LED1-4 引脚输出驱动	ILED=2mA		2.5	3	4.0	V
ΔV_{RECHRG}	再充电电池门限电压	V _{FLOAT} -V _{RECHRG}		100	120	150	mV
T_{LIM}	芯片保护温度				145		$^{\circ}$ C
R _{ONP2}	功率 PMOS2 导通电阻				30		mΩ
ILMTp	功率 PMOS2 逐周期限流	0.25V/Ronp2			6		A
t _{RECHARGE}	再充电比较器滤波时间	V _{BAT} 高至低		300	500	700	mS
t_{TERM}	终止比较器滤波时间	I _{BAT} 降至C/5 以下		1	1.8	2.5	mS

6

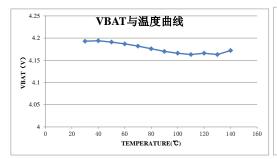


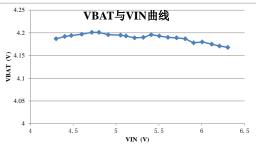
除非指定,否则,VIN=0, VBAT=3.8V,TEMP=25℃,VIO=5V,Rout=5Ω,Cout=88uF,Rsb=8.2mΩ,KEY~键启动升压

符号	参数	条件		最小值	典型值	最大值	单位
	升压部分						
VBAT	输入电源电压		•	3.0	3.8	4.5	V
		升压VIO=5V,Rout=50K		2	3	10	mA
I_{BAT}	电池输出电流(不包含灯)	待机模式	•	4	6	15	μΑ
-DAI	313 MAET 3200(1 3 E/A)	关机模式(VBAT=2.2)	•	0	0.5	2	μΑ
$V_{ m OUT}$	输出电压精度	$R_S=8.2m\Omega$, $I_{OUT}=100mA$		4.87	5.02	5.17	V
VIlmt	恒流设置电压有效范围	VIlmt 有 VIO 经分压电阻取 得		0		1	V
I _{OUT MAX}	VOUT(4.8V)最大电流	$R_S=8.2m\Omega$, VIImt=0.1V		2.8	3	3.2	A
Iout_LS	轻载停机电流门限	L=2.2uH(随电感正相关)		20	50	100	mA
Fup	升压振荡频率			250	300	400	KHz
DMAX	最大占空比				85%		
DMIN	最小占空比			0%			
VLMTn	功率 NMOS1 逐周期限流 电压	设计值		0.22	0.25	0.28	V
	电量 LED 显示周期			2.5	3	3.5	S
Tdisp	TP5602B 电量 LED 显示 周期				长亮		S
Tnoload	轻载检测周期	I _{OUT} =200mA下降到 5mA		5	10	20	S
VuvB3	电池欠压待机点	VBAT 从高到低		2.8	3	3.2	V
VuvB2	电池过低关机点	VBAT从高到低		2.1	2.4	2.6	V
VLED	LED1-4 引脚输出驱动	ILED=2mA		2.5	3	4.0	V
$TEMP_{LIM}$	芯片保护温度				145		$^{\circ}$
T_{ss_up}	升压软启动时间	VIO=0 至 VBAT(C _{OUT} =100uF)		100	500	2000	uS
IBAT_UP_ST	输出短路时电池电流			50	100	200	mA
TUP_ST	VIO 短路检测时间	VIO=0V		200	450	600	mS



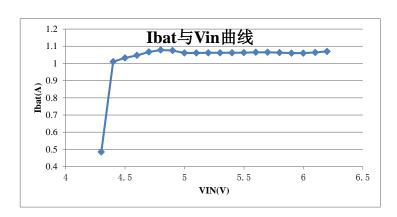
典型性能指标 (锂电池充电模式)





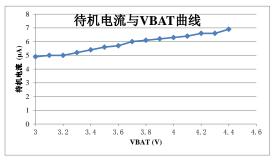
截止电压与环境温度关系

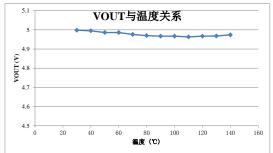
截止电压与电源电压关系



充电电流与电源电压关系

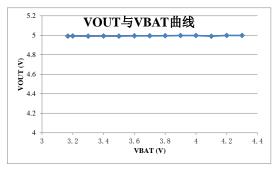
典型性能指标 (升压模式)





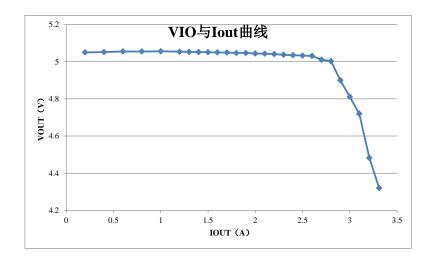
待机电流与电池电压的关系

VOUT与环境温度的关系

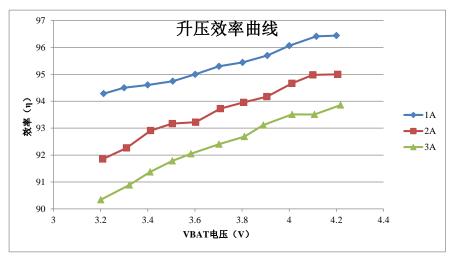


VOUT与电池电压的关系

8



VOUT与输出电流的关系



升压效率与VBAT的关系

9



引脚功能及使用说明

VIO(引脚 2,3,5): 5V输入/出公用端口

充电时与外部 5V电源相连,作为本机电池充电电源,系统自动转为充电模式(如果原来在升压模式,可能延时 6S-12S到升压自动停止后);升压时(key~键按下),作为 5V输出口。

VIO也是内部工作电源的主电源,所以电容的位置对输出精度十分重要,需要优先安排并紧靠近芯片口。详见PCB板注意事项。5V2A建议外接资片电容 2*22uF,如果大电流下VIO纹波较大或不稳定,建议外接更大电容,如 5V3A时需接 4*22uF或 2*47uF,或更大更稳定。

如外部接PMOS1 时的使用:

当芯片处于待机模式(充电模式: dn~_up=0), VIN 通过PMOS1 管输出到VIO当VIO>4.25V, TP5602 自动进入充电模式。

当 芯 片 处 于 升 压 模 式 (dn~_up=VIO=5V),保护PMOS1 管为 关闭状态,VIN不输出到VIO,VIN上 电不会自动触发充电模式,只有当升 压模式结束后,dn~_up=0 时,才会进入充电模式;但如果将auto_up引脚通过电阻接VIN则可以自动检测VIN上电,当auto_up>3.5V时,自动关闭升压,启动充电模式。

GND_A, GND_D(引脚 18,7)内部地线

GND_P(引脚 22) 驱动和功率地线

LX (引脚 4,23,24): 内置功率 PMOS2 管、外置 NMOS 漏极连接点。

LX 与外部电感相连作为电池充电 放电的开关端,也作为同步电压和过 流电压的检测端。

Vint1 (引脚 6): 内部电源 1。外接电容 1uF。

工作时(充电或升压)启动=VIO, 待机时=0;

Vint2(引脚 8): 内部主电源 2, 外接电容 1uF。一直输出系统最高电源。

由内部电源切换电路自动切换到 VBAT, VIO 中的最高电平作为内部工 作电源。工作时=VIO, 待机时=VBAT。

为防止切换模式时 VIO 瞬变过大, 引起 Vint2 和 VIO 两路电源瞬态不同, 内部产生误操作。Vint2 和 VIO 之间需 要跨接 1uF 的电容,抑制电源瞬态差 异。

LED4-1 (引脚 9, 10, 11, 12): 外接 发光二极管 LED 的正极,正常工作最 高电平 5V,可以驱动蓝光,白光,红, 绿 LED 等。

正常工作电量指示端口; 异常状态报警指示。内部有 1K 欧姆的限流电阻。用户还可根据不同 LED 和亮度选择外加串联电阻,详见 LED 指示说明。

auto_up (引脚 13): 模式检测端口 2。 典型用法直接接 **GND**;

高电平时强制为充电模式(禁止升压);下降沿强制启动一次升压;一直低电平时模式由 KEY~键决定;(在充电或待机模式下,充电与否决定于VIN或 VIO 是否有电压)。

用法 1:

3M 电阻和 VIN 端相连(在有外部 PMOS1 的其他应用场合,见后页图 3),检测到高电平后自动停止升压模式,进入充电模式;检测到 VIN 下降沿(掉电)自动启动升压模式,VIO 输出

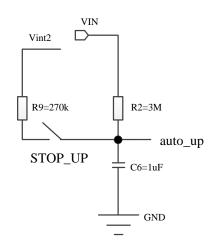


5V,升压,轻载时自动停机。接法如应用图 3:

(VIO 输入/输出单端口方案图 1,用 法 1 无效)

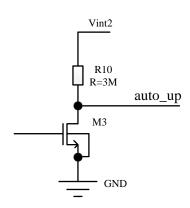
用法 2:

按下开关后,端口接 Vint2 高电平, 手动关闭升压模式,释放后启动升压 模式,轻载自动停机。接法如下图:



用法 3:

外部 MPU 控制充电模式和升压模式,微控制器的 NMOS 开漏端直接接auto_up,通过电阻上拉 Vint2 高电平。MPU 关闭(拉高端口)或开启(给一个下降沿)升压模式(无须 KEY~按键),轻载自动停机。接法如下:



如果直接接 0 电位, VIN 掉电时不会自动转升压模式。VIO 输出为 0。为了防止在模式切换时 VIN 毛刺引起误

触发, auto_up 端口需要使用 RC 延时 回路, C_{OUT} 越大, 需要 RC 延时越大。 一般>500mS, (3M, 1uF)。

VBAT (引脚 14): 电池电压端。

将电池的正端连接到此管脚。

VS (引脚 15): 电池输入/出电流检测端。

Rsb 连接 VBAT 和 VS,作为电池 电流的取样电阻,内部有电流极性自 动判别电路。

Rsb 设置最大充电电流值,V_IImt 设置最大放电电流值,其他电流内部自动调整。

Vsb=VS-VBAT

恒流充电时 Vsb=25mV

最大输入电流 ISET0=25mV/Rsb

涓流充电时 Vsb=5mV

最大输入电流 ISET1=5mV/Rsb

升压放电时 Vbsmax=4*25mV

最大放电限流约 ISET2=4*ISET0(无电 压调制时即 VIO=5V, V_IImt=1/5VIO) ISET2 由内部 V_IImt(VIO 取样电压)。 调制时:

V_Ilmt 下降时 ISET2 减少, V_Ilmt=[0-1]; ISET2有Rsb和V_Ilmt 共同决定。

例如:

Rsb= $25m\Omega$, V Ilmt=0.5V(=1/10 VIO)

则充电恒流 ISET0=0.025/0.025=1A 5V OUT :

ISET2=(0.025+0.075*0.5)/0.025=2.5A 输出限流 I_{OUT}≈0.9*4.2*2.5/5=1.8A

如果 V_IImt=0.25(=1/20 VIO)则 ISET2=(0.025+0.075*0.25)/0.025=1.7A 输出限流 I_{OUT}≈0.9*4.2*1.75/5=1.3A



电池电流设置示表(客户须以实测为准,下表为我司演示版测试值)

Rsb	充 电	V_Ilmt=	Iout(A)	Iout(A)
毫	限 流	5*	(vout=4.8@	(vout=4.8@
欧	(A)	R8/(R7+R8)	VB=4.2)	VB=3.6)
25	1.0	0.5	1.9A	1.76A
25	1.0	0.12	1.0A	0.90A
25	1.0	0	0.8A	0.77A
12	2	0.5	3.5A	3.40A
12	2	0.1	2.0A	1.90A
12	2	0	1.6A	1.49A
8	3	0.5		
8	3	0.1	3.0A	2.94A
8	3	0	2.5A	2.34A

V-IImt (引脚 16): 电池放电电流设置端。

充电时,该端口不起作用,放电时设置不同的电压初始值 0-1V,(内部有1V 嵌位电路)。可以改变电池放电最大限流倍数。如果通过分压电阻取样VIO,可以得到随 VIO 调制的输入限流值(与 Rsb 共同作用),从而保持输出电流恒定不变。

key~ (引脚 17): 升压模式端口 1

外部按键,低脉冲有效。按键后可启动升压模式(当 auto_up=低):

如 VBAT≤3V; 或 VIO 短路过流等,则 LED 异常报警闪 6 次后自动待机,不升压。

如 VBAT>3V则电量指示灯显示约 5 秒后熄灭。VIO 输出 5V 电源。再次 按键 key~重新显示电量 5 秒。如果连续输出轻载,(如 Iout≤30mA),约 10 秒后自动停止,转为待机模式,电池 耗电≤6uA。

长按按键 2.5S 升压停机。

dn~_up(引脚 19): 多用途保护 PMOS1的栅输入。也是工作状态指示口:

dn~_up=0 充电模式,为同步降压模式,外接 PMOS1 导通(方案图 3), PMOS2 为充电开关管, NMOS 为降压同步管。

当系统损坏如 PMOS2 穿通等引起 VBAT≥4.3V 过压,保护电路起作用:dn~_up=高阻态,通过外加 1M 电阻上 拉到 VIN 保护管 PMOS1 强制关闭,停止充电。

外接 C7=0.1uF 电容防止 VBAT=0V时,可能出现的充电不启动

dn~_up=VIO(5V) 升 压 模 式 , PMOS1 关闭, NMOS 为放电开关管, PMOS2 为升压同步管。

VREG (引脚 20): 内部电源 3。

VREG 是一个内部二级电源,它外接一个 0.1uF 旁路电容到地。

 $VREG \approx 4.0V$ 。只有在工作时启动, 待机时为 0V。

EXT (引脚 21): 外置 NMOS 栅驱动端。

外扩一个功率 NMOS, 开关信号, CMOS 输出, 高电平为 VIO, 低电平为 0。最大可驱动 Cg=2000p 的 NMOS 功率管。



工作原理说明:

TP5602 是专门为需要内置单节 4.2V 锂离子电池充电,同时需要高效 大功率 5V 稳定 DC 电源的系统而设计。由于芯片内部集成多种电池输入输出保护电路,外部无须电池保护板或电路。加上内置 4 路电量显示和报警显示。独特的电感和功率管的复用技术,使用一套器件和升压和降压自动切换模式,完成高效率大电流的同步降压充电和同步升压输出。系统生产复杂性大大降低,成本降低的同时系统可靠性和安全性大大提高。

外置 PMOS1: 独特的多用途保护和旁路 PMOS1 的设计,不仅可以保证边充电同时旁路输出,还可防止充电电源反接。电池电压过压时 PMOS1 也会自动切断,加上 PMOS2 的充电限压电路,双重保护电池。在升压时 PMOS1 关闭,以免 VIO 反漏到 VIN 端。

充电过程:

在待机模式时,PMOS1 是导通状态,dn~up=0,VIO=VIN。

VIN 上电后: 当 VIO<3.8V 未启动充电电路。电池无电流输入; LED 灯不亮; 当 3.8<VIO<4.3,未启动充电电路, LED 灯显示电量;

当 VIO≥4.3V 启动充电电路,同步降压模式启动,PMOS2 为电感充电,NMOS 为同步管,电流流过 VS 外接Rsb 到电池。Vsb 为采样电压,控制开关占空比,控制充电电流值。

LED 灯显示电量如下;

电池电	闪烁/长亮	闪烁方式
压(充电		
模式)		
0-3.0	LED1/无长亮	0.5 秒 50%
		快闪
3.0-3.5	LED1/无	1秒25%闪
3.5-3.8	LED2/LED1	1秒25%闪
3.8-4.0	LED3/LED2-1	1秒25%闪
4.0-4.2	LED4/LED3-1	1秒25%闪
4.2	无闪/LED4-1	

充电过程分:

涓流(0<=VBAT<3.0): Vsb=5mV, LED1 高频闪动,其他 LED 灭。 恒流(3.0V<VBAT<4.18): Vsb=25mV

LED 最高位慢闪,其他低位长亮。 恒压(4.18<VBAT<4.20),四个 LED 都 长亮,不闪,充满。

恒流设置: ISET0=Vsb/Rsb=25mV/Rsb 涓流: ISET1=5mV/Rsb

恒压阶段电流会随 VBAT 上升急 剧下降,直到充电电流约为 20% ISET0 以下维持 1.8mS 以上,产生充满信号: LED 长亮,降压管关闭。

自动再充电: 电池充满到 4.2V 后 待机,如果电池电压再下降到 4.08V 左右重新启动充电过程直到 VBAT 回到 4.2V。

内部过温达到 140 度,保护电路自动降低输出电流,直到内部温度不再上升。该功能使得用户无须担心芯片过热而损坏。

VIN 掉电后功能选择:

VIN 掉电至 4.3V 时,自适应电路 启动自动降低输出电流直到 VIN 不再 降低,该功能可以将大电流充电系统 用 USB 或小功率电源适配器、太阳电



池来做电源,而避免电源复位或重启。 VIN 断电:

auto_up 端口,不固定接 VIN,则, auto_up 和 key~可作为手动模式转换 按键。VIN 掉电后无自动转升压功能, 直接待机;但充电时 key~键也不禁止 (停止充电模式,进入升压模式, VIO=VIN 和升压 5V 的高者)。auto_up 键后将进入充电或待机模式(停止升压 模式)。

auto_up 端口 RC 回路接到 VIN(如 典型应用电路),则 VIN 上电后即自动充电模式,不管以前什么状态,key~键无效。VIN 掉电后自动转升压模式(无须 key~按键),key~键也有效。推荐使用该功能选项。

放电升压过程:

典型应用情况下,充电掉电和key~低电平脉冲都可触发 VIO 从 0V 到 5V 的升压过程。同时 LED 显示电量3秒左右后熄灭(TP5602B 为长亮)。

升 压 时 , PMOS1 关 闭 , dn~_up=VIO,VIN=0V,Vint1 和 VREG 启动,EXT 驱动 NMOS 开关电感,PMOS2 为升压同步,将 VIO 泵至 5V DC,供手机、平板电脑等便携式设备充电,使用。

内部有 VIO 自适应软启动限流 (VIO上升,允许输出电流越大)、逐 周期限流、限制平均电池电流、芯片过温度保护、长时(250mS)短路和过流停机保护等多重保护功能,外部可不需要使用额外的电池保护电路。也减少外部保护电路的损耗,提高电池电源转换效率。

TP5602 升压时 LED 灯显示如下:

电池电压	闪烁/ 长亮 3	闪烁方式
(放电模	秒	
式)		
0 - 2.4	都不亮	关机
2.4- 3.0	LED4-1/无长	快闪6次
	亮	欠压报警
3.0-3.5	无/LED1	
3.5-3.7	无/LED2-1	
3.7-3.9	无/LED3-1	
3.9-4.2	无/LED4-1	
VIO 过载	LED4-1/无	快闪6次
芯片过温	LED4-1/无	快闪6次

TP5602B 升压时 LED 灯显示如下:

电池电压	闪烁/长亮	闪烁方式
(放电模		
式)		
0 - 2.4	都不亮	关机
2.4- 3.0	LED4-1/无长	快闪6次
	亮	欠压报警
3.0-3.5	无/LED1	
3.5-3.7	无/LED2-1	
3.7-3.9	无/LED3-1	
3.9-4.2	无/LED4-1	
VIO 过载	LED4-1/无	快闪6次
芯片过温	LED4-1/无	快闪6次

升压工作时的自动停止:

升压电路正常工作开始后,如果输出有负载,同时负载足够大,典型条件下 I_{OUT}>50mA,升压电路一直工作,不停机;如果轻载 I_{OUT}<50mA(根据温度,电池电压,电感值等会有所不同),一般表明外部充电结束,或无负载接入,经过连续 10S 左右的持续检测,芯片将自动停止升压,转为待机模式;



待机模式下可以再次升压(key~键低电平脉冲触发),也可以自动进入充电(VIN >4.3V)待机模式下,VIO,VIN与VBAT完全隔离,芯片系统耗电仅仅6uA。

升压时需要手动或外部控制停止

不管是否轻载,用户可以将auto_up端口通过开关或电阻上拉到高电平 Vint2。升压即停止,key~键不起作用,此时为待机状态,可以进入充电模式; auto_up变低后,芯片又自动回到升压状态(不管是否按下 key~键)。CPU 控制停机的接法:

CPU 开漏 NMOS 口输出上拉 3M 欧姆的电阻接 auto_up 与 Vint2 之间。 大电阻 3M 电阻是为了降低电池待机 电流。

Key~引脚控制停机方法:

典型电路中 KEY2 长按 2.5S 即可实现升压停机。

VIO 和输出电流:

芯片内部有 VIO=5V 固定输出的的取样电阻,用户无须外部调整电阻。输出最大电流有 Rsb 和 V_Ilmt 的值决定,(见 VS 端口的设置)。最大充电电流有 Rsb 设置,与 V_Ilmt 无关;

电池最大放电电流由 V_Ilmt 外部设置为 1-4 倍(对应 0V-1V V_Ilmt)的最大充电电流。升压时加上内置的VBAT 电压和 VIO 调制作用以及升压效率(典型 93.5%)共同决定 I_{OUT} 的最大值。VIO=5V 下降到 VBAT,I_{OUT} 上升。VIO 不变,VBAT 降低,I_{OUT} 下降。

VIO 连续 250mS 小于 VBAT,则 表示输出过载或短路,内部自动停机 保护,并**6次闪灯报警过载。**

电池欠压保护:

升压时,如果电池电压<3V,则自动停机**,并闪灯 6 次报警欠压**。

如果电池电压<2.4V为防止锂电池 损坏,芯片内部全部关机并处于锁定 状态。电池电流降到 1uA 以下,外部 按键无效。以后即使电池电压回到 2.4V 以上也不会解锁工作,只有 VIN 加高电平后充电一次自动复位,才可 解除锁定。

(注意: 在工程师测试芯片或生产时,如果 VBAT 短时移处,可能出现由于 C_{BAT} 的电容电压<2.4V 停机锁定造成 VBAT 再加电时不工作现象,只需要 VIN 上电一下,或将 C_{BAT} 的电容放电到 0 再 VBAT 上电复位也可)。

芯片内部热限制

无论是充电还是放电模式,如果芯片温度试图升至约 145℃的预设值以上,则一个内部热反馈环路将减小设定的电池电流。该功能可防止 TP5602 过热,并允许用户提高给定电路板功率处理能力的上限而没有损坏 TP5602 的风险。在系统芯片保证将在最坏情况条件下自动减小电流的前提下,可根据典型(而不是最坏情况)环境温度来设定充/放电电流。

输入 VIN、输出 VIO、VS、VBAT 端 电容

可以使用多种类型瓷片电容器,但需要高品质的功率电容。最好另加一个 0.1uF 的瓷片电容进行旁路,并且连接位置务必紧靠近芯片引脚。其他端口电容可以使用非功率小型瓷片电容。



尤其 VIO 的电容可以尽量加大容值和功率能力(如输出 5V2A 时用 2个 22uF 的或 47uF 的瓷片功率电容并联于两个 VIO 脚,如果大电流下 VIO 纹波较大或不稳定,建议外接更大电容,如设置输出 5V3A 时,VIO 端需接4个1206 封装的 22uF或2个47uF,或更大更稳定),并需要十分靠近芯片 VIO 脚。

同等情况下选用较高的电感值,系统 效率会更高。

TP5602 其他应用方案及注意事项 见后页:

热考虑

虽然 QFN24 封装的外形尺寸很 小,但其散热特性很好,然而需要 PCB 版的设计配合,最好采用一个热设计 精良的 PCB 板布局以最大幅度地增加 可使用的充电/放电电流。用于耗散 IC 所产生的热量的散热通路从芯片至引 线框架,并通过芯片底部散热片和过 孔到达 PCB 背板铜面。引脚相连的铜 箔面积应尽可能地宽阔,并向外延伸 至较大的铜面积, 以便将热量散播到 周围环境中。建议至内部或背部铜电 路层的多加通孔,改善充电器的总体 热性能。当进行 PCB 板布局设计时, 电路板上与充电器无关的其他热源也 是必须予以考虑的,因为它们将对总 体温升和最大充电电流有所影响。

电感选择

充电时 F_{OSC}=700KHz, 放电时为降低 MOS 管的损耗, F_{OSC}降频为300KHz。

根据不同的输出电流要求, 电感取值 1uH-2.2uH, 升压输出 5V2A 推荐使用 2.2uH, 输出 5V3A 推荐使用 1uH。

电感额定电流建议选用大于升压输出电流 2 倍,内阻较小的功率电感,



TP5602 其他应用电路及器件

图 3、图 4为 TP5602 的其他应用电路图:

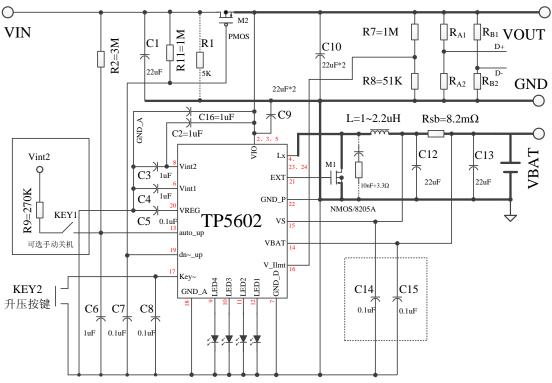
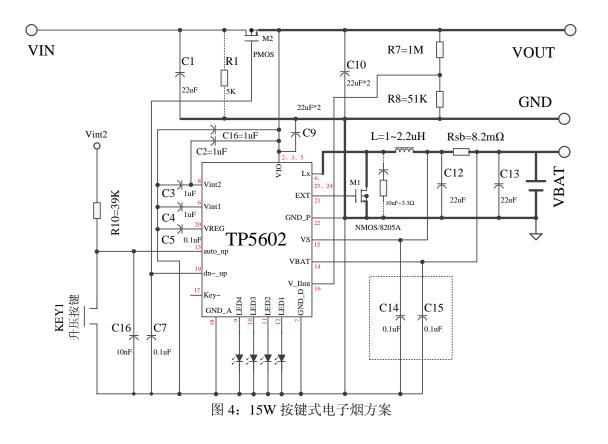


图 3: 升压时可实现手动或 CPU 控制停机



南京拓微集成电路有限公司 NanJing Top Power ASIC Corp.

下表为典型应用电路的元器件推荐清单:

表 2 4.2V 锂离子电池 3A 充电、5V 3A 升压

编号	元器件名称	型号&规格	位号	用量	备注	
1	主控 IC	TP5602 QFN24 -4*4	U1	1		
2	贴片功率电感	双线并绕 1.0uH/10*10	L	1	饱和 Isat、温升电流 Idc 大于 7A, DCR 小于 0.01, 感值 1.0uH	
3	贴片电容	0.1uF/0603 10%	C5 C7 C8 C14 C15	5	耐压不低于 16V,建议 使用贴片陶瓷电容, <mark>红</mark>	
4	贴片电容	22uF/1206 10%	C1 C9 C10 C12 C13	7	使用	
5	贴片电容	1uF/0603 10%	C2 C3 C4 C6 C16	5	放置	
6	贴片电容	0.01uF/0603 10%	CLX	1	TMC 测净新效果件	
7	贴片电阻	3.3R/0805 1%	RLX	1	EMC 测试预留器件	
8	贴片电阻	0.0082R/1206 1%	RSB	1	精度 1%, 封装是 1206 或以上	
9	贴片电阻	5.1K/0603 5%	R1	1		
10	贴片电阻	3M/0603 5%	R2	1		
11	贴片电阻	1M/0603 5%	R7 R11	2		
12	贴片电阻	51K/0603 5%	R8	1		
13	贴片 LED	0603 蓝色	LED1~4	4	电量指示用	
14	贴片 MOS	8205A/TSSOP8	M1	1	同步 NMOS	
15	贴片 MOS	2301/SOT23-3	M2	2	开关 PMOS	
16	按键开关	6.5mm*5.1mm	KEY2	1		
17	迷你 USB	Micro USB 母座 5 脚全贴	输入用	1	按键+插座	
18	USB 母座	USB-A 母插座贴 片/白色, 4P USB 插座母座 A 型	输出用	1	1.4 诞十1出 <i>严</i>	



TP5602 使用注意事项

- 1. 电路中电容都应尽量靠近芯片,而不是靠近PCB板的端口。以VIO端电容为例: 当输出为5V2A时,VIO端需接2个22uF的电容,一个放芯片VIO引脚边,一个 放USB输出口边,或两个都放在VIO引脚边;当输出为5V3A时,VIO端需接4 个22uF的电容,此时可在芯片VIO引脚处接2个22uF,USB口端接2个22uF。
- 2. VIO、VS、VBAT、VIN端须使用高品质陶瓷电容。VIO引脚建议使用1206封装的瓷片电容。
- 3. 电感请选用电流能力足够的功率电感,主要考虑升压时的电流要求,一般大于2倍I_{OUT}最大电流。电感值在1uH~2.2uH之间。
- 4. 对于VIO及LX通过电流回路的走线应比其他电流信号线更宽。
- 5. 注意各电容接地线节点位置,Vint1、Vint2、VREG几个端口电容应尽量接同一侧地线,优先靠近GND_A、GND_D、GND_P。VIO、VBAT、VS用同一侧地线,良好连接到PCB VIO处地。
- 6. 使用芯片在大电流工作中,应考虑芯片底部散热片与背面PCB的良好连接, 保证散热良好。
- 7. TP5602 QFN芯片的维修拆、装方法:

TP5602 是超小型 QFN24 封装,拆装时建议用可调温度的热风枪。

拆:将热风枪出风口温度定义为 280-300 度,风口先对准 QFN 四边吹预 热 20 秒,风口靠近芯片中央约 10mm 之内,再对准芯片中心持续吹热芯片,约 20~60 秒(不同的散热片时间不同),待芯片可以移动时,迅速用镊子取出。如果芯片背面有大面积过孔或散热片,建议先用烙铁和吸锡枪从背孔处吸去大部分焊锡。

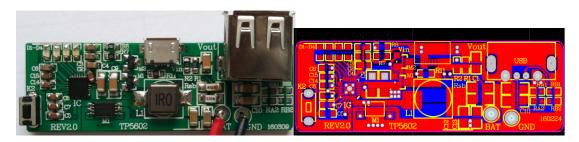
- 装: 1) 用烙铁在 PCB QFN 贴片引脚处均匀补少量锡,或在 PCB QFN 引脚处直接涂抹一薄层锡膏。另芯片引脚也可补少量锡。
 - 2) 用镊子捏起 QFN 芯片,热风枪对准芯片底部(有脚面)吹5秒,迅速将底部表面涂抹一层助焊剂。
 - 3) 用热风枪预热 PCB 板上 QFN 焊盘,将 QFN 芯片按照脚位正确顺序放在 PCB 的焊接位置中心,大概对齐即可。
 - 4) 用热风枪从芯片正上方对芯片吹风20~60秒,必要时芯片四周也可以吹热,芯片会由于融化焊锡表面张力自动对齐引脚位置。如果位置差异过大,可用镊子边吹边轻微调整,待冷却后使用。

其他更多注意事项可参考: TP56系列 应用事项。



TP5602 演示板电路及使用说明

下图为 TP5602 的演示版图形及 PCB 示意图 (TP5602B 通用), 采用典型应用图 1。



演示版及 PCB 示意图 采用典型应用图 1

注: PCB 板背面未提供,为大面积地线与过孔,无元器件。为提高效率,演示版铜箔为加厚为 2OZ 。

TP5602 演示版引脚及端口说明: 充电 4.2V 3A, 放电 5V 3A

输入: Micro USB。输出: USB。

BAT: 电池端。

正确连接电源和电池,即可充电,充电中 LED 逐级闪烁,充电结束四颗灯全亮,具体参考充电 LED 显示。K2 键是升压按键,不充电时,按下开始升压。

K1 是升压停机开关。按下升压停止,放开启动一次升压。

在恒流充电阶段,可以在电池正极端串联电流表,检测充电电流,电流表使用大量程档。考虑到电流表内阻,不建议在测试最终充电完毕电池电压模式中串联电流表。内阻会引起关断后电池的实际电压低于芯片本身关断电压。

演示版布局特别注意事项:

GND: 地线布局极为重要,芯片有数字地、模拟地及功率地,三个地线建议与芯片散热片接一起,输出地线以 Vout 端口为主。原理图中地线已用粗细线区分,细线为静态地,加粗的地线为功率地,布局时可参考。建议芯片周围的小电容的地线与静态地相接。

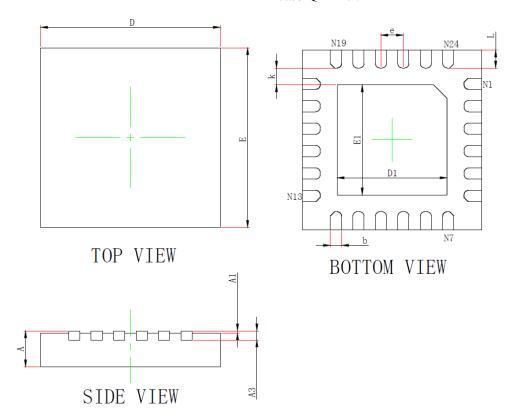
VIO 端电容: VIO 共有三个 PIN,需接在一起,且需要接 2~4 个 22uF 的电容(根据实际应用电流情况,电流越大,需要外接的 C_{OUT} 的电容越大,如 2*47uF 的电容,更大更稳定),且靠近芯片端口。电容地也要接到大电流的地。

注:建议 PCB 中 QFN24 的库文件引脚长度略大于芯片长度(我司建议 PCB 布局引脚长 1mm,宽 0.28mm),便于焊接。



封装描述

4mm*4mm 24 引脚 QFN 封装

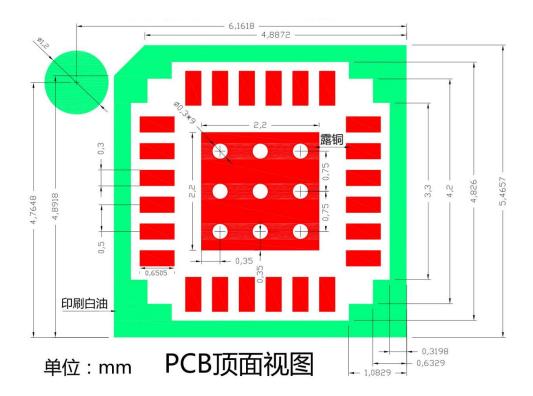


Size	Min	TYP	Max	Size Symbol	Min	TYP	Max
A	0.70	0.75	0.80	D1	2.20	2.40	2.55
A1	0.00	-	0.05	E1	2.20	2.40	2.55
A3		0.203REF		e		0.50TYP	
b	0.20	0.25	0.30	K	0.20	-	-
D	3.90	4.00	4.10	L	0.30	0.40	0.50
Е	3.90	4.00	4.10				

注:上述为芯片尺寸,建议 PCB 中 QFN24 的库文件引脚长度大于芯片长度,便于焊接。



QFN24 PCB 参考



版本历史

日期	版本说明	版本
2015.5.20	第一版	Rev1.0
2015.9.16	修改部分指标上下不一致; 电路图中加引脚标号。	Rev1.1
2016.2.26	芯片升级,简化外围配置以及地线方案优化	Rev2.0
2016.7.20	增加 TP5602B,升压时 LED 长亮方案	Rev2.1